А.А.Вейник, инженер, А.И.Вейник, чл.-корр. АН БССР

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

Известно, что при измерении температуры формы, особенно неметаллической, обычно приходится сталкиваться с проблемой уменьшения влияния сверлений и электродов термопары, искажающих исследуемое температурное поле. Отсос теплоты от точки замера особенно ощутим, если теплопроводность формы много меньше теплопроводности электродов термопары.

С целью устранения указанного недостатка предлагается использовать в качестве датчика для измерения температуры термоэлектрический полупроводниковый элемент, описанный в работе [1]. Элемент представляет собой пакет разнородных тонких пластинок, одна из которых изготовлена из монокристалла германия, кремния или другого полупроводникового материала. К обеим плоскостям полупроводниковой пластины прикреплены разнородные металлические, например медная и алюминиевая. Чтобы в качестве выводов от датчика использовать обычный тонкий медный провод и не получить при этом дополнительных спаев, искажающих показания прибора, целесообразно собрать пакет из пластинок, расположенных в следующем порядке: медная, полупроводниковая, алюминиевая, медная. К медным пластинкам прикрепляются медные же токоотводящие провода.

Датчик должен быть ориентирован в форме вдоль изотермической поверхности. Длина и ширина датчика могут выбираться от нескольких долей до нескольких десятков миллиметров. Толшина всего пакета может колебаться от десятков микрометров до нескольких миллиметров. Толшины отдельных слоев выбираются в зависимости от теплопроводности и теплоемкости материала формы. Широкому диапазону изменения этих параметров способствуют крайне высокая теплопроводность меди и алюминия и низкая теплопроводность полупроводника. Благодаря этому удается скомпоновать датчик, близкий по своим свойствам как к металлической, так и к неметаллической формам, который очень удобен в работе.

Суммарная (эффективная) теплопроводность датчика L $_{\mathfrak{I}}$ и теплопроводности и толщины отдельных его слоев – меди ($_{\mathfrak{L}_{1}}$ и

 ${f X}_1$), полупроводника (${f L}_2$ и ${f X}_2$) и алюминия (${f L}_3$ и ${f X}_3$) – связаны соотношением

$$\frac{X}{L_9} = \frac{X}{L} = \frac{X_1}{L_1} + \frac{X_2}{L_2} + \frac{X_3}{L_3},\tag{1}$$

где $X = X_1 + X_2 + X_3$.

С помощью этого соотношения толщины слоев датчика выбираются таким образом, чтобы его эффективная теплопроводность \mathbf{L}_2 была равна фактической теплопроводности формы \mathbf{L} .

В нестационарных условиях следует принимать во внимание также удельные теплоемкости и плотности формы (с и ρ), отдельных слоев и датчика в целом (c_9 и ρ_9), причем произведение ρ -с представляет собой удельную объемную теплоемкость. Эффективная удельная объемная теплоемкость датчика ρ_9 c_9 связана с удельными объемными теплоемкостями отдельных слоев равенством

$$\rho_{3}c_{3} = \rho c = X_{1}\rho_{1}c_{1} + X_{2}\rho_{2}c_{2} + X_{3}\rho_{3}c_{3}.$$
 (3)

Если в ходе выбора материала и толщины пластинок датчика возникнет некоторое расхождение результатов, найденных по уравнениям (1) и (3), то для зоны формы с незначительными изменениями температуры предпочтение следует отдавать уравнению (1), а для зоны с большими изменениями температуры - уравнению (3).

Очень тонкие металлические слои могут быть получены путем напыления их на полупроводник в вакууме. K ним могут быть припаяны более толстые слои и т. п.

Преимущество обсуждаемого элемента заключается в том, что он дает электродвижущую силу (ЭДС), не равную нулю, в изотермических условиях, т. е. показывает абсолютную температуру формы и, следовательно, нет надобности заботиться об организации холодного спая. Тарируется датчик обычными методами, зависимость ЭДС от температуры получается нелинейной. Элемент с кристаллом, например германия, дает хорошие результаты до температуры 873 К.

Литература

1. Marinescu Matei. High efficiency thermoelectric generator operating on the basis of a new thermo-electric effekt. Proceedings of the International Conference on Thermoelectric Energy Conwersion, Arlington, Tex., 1976. New York, N. Y., 1976, p. 120-125,